



Title of Change:	Fab, Assembly Site and Assembly Material Change for NLHV011USG	
Proposed first ship date:	19 June 2019	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <logic.fpcn@onsemi.com>	
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Francis.Lualhati @onsemi.com>	
Type of notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Change Part Identification:	Marking Style will be changed. CS code on the label will be changed from US to JP as well.	
Change Category:	☒ Wafer Fab Change ☒ Assembly Change ☒ Test Change ☐ Other _____	
Change Sub-Category(s):	☐ Manufacturing Site Addition ☒ Material Change ☐ Datasheet/Product Doc change ☒ Manufacturing Site Transfer ☐ Product specific change ☒ Shipping/Packaging/Marking ☒ Manufacturing Process Change ☐ Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Seremban, Malaysia Subcon, Thailand	External Foundry: Foundry Israel, Foundry Japan
Description and Purpose: FPCN22512X was issued to qualify new die source in Japan in subcon Thailand to increase the front end and back end capacity and standardizing materials.		
Material to be changed	Before Change (Existing flow)	After Change (New flow)
Assy Site	Onsemi Malaysia	Subcon Thailand
Mold Compound	MC SUMITOMO EME-G600FB	Molding Compound G600
Lead Frame	US8 Ag STRIPE 4 TIE BAR	PPF+ME2; US8; DAP 59x38
Die Attach	DA EN4370K3 SNAP CURE NON-C	Non-Conductive DAF, HR-5140
Die Source	Foundry in Israel	Foundry in Japan
Plating	100% Sn	Preplated
Product marking change	MARKING DIAGRAM A2 = Device Code M = Date Code* • = Pb-Free Package	MARKING DIAGRAM XXXX=Device Code, A= Assy location, L= Lot Code, Y=Year Code, W =Week Code

**Reliability Data Summary:****QV Device Name** NLHV011USG**RMS** S44406**PACKAGE** US8, 2.0x2.3mm

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/30
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/ 45

Electrical Characteristic Summary:

Electrical characteristics available upon request.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the PCN Customized Portal.

Part Number	Qualification Vehicle
NLHV011USG	NLHV011USG

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22512X

発行日 : 12 March 2019

変更件名:	NLHV011USG のファブ拠点、組立て拠点、および組立材料の変更	
初回出荷予定日:	19 June 2019	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <logic.fpcn@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。	
追加の信頼性データ:	お客様の地域のオン・セミコンダクター営業所または <Francis.Lualhati @onsemi.com> にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> 宛てをお願いします。	
変更部品の識別:	捺印様式が変更されます。ラベルの CS (もしくは DIFFUSED IN) コードも US から JP に変更されます。	
変更カテゴリ:	☒ ウェハファブの変更 ☒ アセンブリの変更 ☒ 試験の変更 ☐ その他 _____	
変更サブカテゴリ:	☐ 製造拠点の追加 ☒ 材料の変更 ☐ データシート/製品資料の変更 ☒ 製造拠点の移転 ☐ 製品仕様の変更 ☒ 出荷/パッケージング/表記 ☒ 製造プロセスの変更 ☐ その他 : _____	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: ON Seremban, Malaysia Subcon, Thailand	外部製造工場 / 下請業者拠点: Foundry Israel, Foundry Japan
説明および目的: FPCN22512X は、生産能力を増強するため日本の新たなダイソースと Subcon Thailand を認定し、組立て材料の標準化を図ることを通知するためのものです。		
	変更前の表記	変更後の表記
組み立て拠点	Onsemi Malaysia	Subcon Thailand
モールド・コンパウンド	MC SUMITOMO EME-G600FB	Molding Compound G600
リードフレーム	US8 Ag STRIPE 4 TIE BAR	PPF+ME2; US8; DAP 59x38
ダイ接着剤	DA EN4370K3 SNAP CURE NON-C	Non-Conductive DAF, HR-5140
ダイソース	Foundry in Israel	Foundry in Japan
メッキ	100% Sn	Preplated
	変更前	変更後
製品表示変更	MARKING DIAGRAM A2 = Device Code M = Date Code* ■ = Pb-Free Package	MARKING DIAGRAM XXXX=Device Code, A= Assy location, L= Lot Code, Y=Year Code, W =Week Code



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22512X

発行日 : 12 March 2019

信頼性データの要約:

デバイス名: NLHV011USG
 RMS: S44406
 パッケージ: US8, 2.0x2.3mm

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/30
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/ 45

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
NLHV011USG	NLHV011USG